

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2004 年 6 月 10 日 (10.06.2004)

PCT

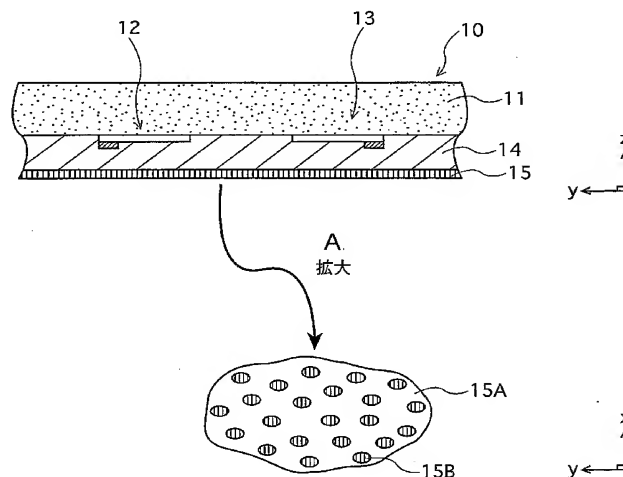
(10) 国際公開番号
WO 2004/049375 A1

- (51) 国際特許分類: **H01J 11/02**, 9/02 (72) 発明者; および
(21) 国際出願番号: PCT/JP2003/014349 (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 森田 幸弘 (MORITA, Yukihiro) [JP/JP]; 〒573-0027 大阪府 枚方市 大垣内町3-14-14-201 Osaka (JP). 北川 雅俊 (KITAGAWA, Masatoshi) [JP/JP]; 〒573-0073 大阪府 枚方市 高田2-13-12 Osaka (JP). 大石 毅一郎 (OISHI, Kiichiro) [JP/JP]; 〒606-0814 京都府 京都市 左京区下鴨芝本町 37-38 Kyoto (JP).
(22) 国際出願日: 2003 年 11 月 12 日 (12.11.2003)
(25) 国際出願の言語: 日本語
(26) 国際公開の言語: 日本語
(30) 優先権データ:
特願 2002-340027 2002 年 11 月 22 日 (22.11.2002) JP
特願 2003-145709 2003 年 5 月 23 日 (23.05.2003) JP
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 松下電器産業株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒571-8501 大阪府 門真市 大字門真1006番地 Osaka (JP). 西谷 幹彦 (NISHITANI, Mikihiko) [JP/JP]; 〒631-0026 奈良県 奈良市 学園緑ヶ丘2-16-5 Nara (JP).
(74) 代理人: 中島 司朗 (NAKAJIMA, Shiro); 〒531-0072 大阪府 大阪市 北区豊崎三丁目2番1号淀川5番館6F Osaka (JP).
(81) 指定国 (国内): CN, JP, KR, US.
(84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).
添付公開書類:
— 国際調査報告書

[続葉有]

(54) Title: PLASMA DISPLAY PANEL AND METHOD FOR MANUFACTURING SAME

(54) 発明の名称: プラズマディスプレイパネルとその製造方法



A...MAGNIFICATION

(57) Abstract: A plasma display panel wherein a first substrate (11) provided with a protective layer (15) is so arranged as to face a second substrate with a discharge space therebetween and the peripheries of the two substrates are sealed and bonded together is disclosed. A surface of the protective layer (15) includes a first material and a second material having different electron emission characteristics. The first material and the second material are exposed to the discharge space, and at least one of the first and second materials exists in a dispersed state. The first material and the second material may respectively be a first crystal (15A) and a second crystal (15B), and the surface of the protective layer may be composed of the first crystal in which the second crystal is dispersed.

[続葉有]

WO 2004/049375 A1



2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(57) 要約:

本発明は、保護層（15）が形成された第1基板（11）が、放電空間を介して第2基板と対向配置され、前記両基板周囲が封着されるプラズマディスプレイパネルであって、保護層（15）の表面には、互いに電子放出特性の異なる第1の材料と第2の材料が、それぞれ前記放電空間に露出し、且つ、第1の材料と第2の材料の少なくとも一方が分散して存在するものとした。

ここで、前記第1の材料は第1の結晶体（15A）であり、前記第2の材料は第2の結晶体（15B）であって、前記保護層の表面において、第1の結晶体中に第2の結晶体が分散されている構成とすることもできる。

明細書

プラズマディスプレイパネルとその製造方法

技術分野 本発明は、プラズマディスプレイパネル等のガス放電パネル
5 の製造方法に関するものであって、特に誘電体層の改質技術に関する。

技術背景

プラズマディスプレイパネル（以下 PDP という）とは、ガス放電で発生した紫外線によって蛍光体を励起発光させ、画像表示するガス放電
10 パネルである。その放電の形成手法から PDP は交流(AC)型と直流(DC)型に分類することが出来るが、AC 型は輝度、発光効率、寿命の点で DC 型より優れているため、このタイプが最も一般的である。

AC 型 PDP は、複数の電極（表示電極またはアドレス電極）とこれを覆うように誘電体層を配した 2 枚の薄いパネルガラスの表面を、複数の
15 隔壁を介して対向させ、当該複数の隔壁の間に蛍光体層を配し、マトリクス状に放電セル（サブピクセル）を形成した状態で、両パネルガラスの間に放電ガスを封入した構成を持つ。表示電極を覆う誘電体層の表面には保護層（膜）が形成される。保護層の特性には、放電開始電圧 V_f （Firing Voltage）と放電セルごとの放電バラツキの発生をともに低減
20 する特性が高いことが望まれる。MgO の結晶膜は耐スパッタ性に優れ、かつ二次電子放出係数の大きい絶縁体であり、保護層として好適な材料である。

PDP では、駆動時にはいわゆるフィールド内時分割階調表示方式に基づき、前記複数の電極に適宜給電して放電ガス中で放電を得ることにより
25 蛍光発光させる。具体的には、PDP の駆動時はまず表示するフレームを複数のサブフレームに分け、各サブフレームをさらに複数の期間に分ける。各サブフレームでは、初期化期間で画面全体の壁電荷を初期化（リセット）した後、アドレス期間で点灯すべき放電セルのみに壁電荷を蓄積させるアドレス放電を行い、その後の放電維持期間ですべての放電セ

ルに対して一斉に交流電圧（サステイン電圧）を印加することによって一定時間放電維持する。PDPで行われる各放電は確率現象に基づいて生じるため、個々の放電セルで放電が発生する率（放電確率と呼ばれる）が基本的にバラツキを有する性質を持つ。したがってこの性質によれば、
5 例えばアドレス放電は、これを実行する印加パルス幅に比例して放電確率を高めることができることになる。

PDPの一般的な構成については、例えば特開平9-92133号公報等に表示されている。

ここでMgOからなる保護層は、低電圧動作を実現するためにも用いられるが、液晶表示装置などに比較して動作電圧が高い性質がある。そのため、駆動集積回路には高耐圧トランジスタが必要となり、PDPのコストを引き上げる要因の1つになっている。このことから現在ではPDPの消費電力を低減するために放電開始電圧 V_f を低減しつつ、コストの掛かる高耐圧トランジスタの使用を控えることが要求されている。

15 一方、保護層をなすMgOの成膜は、真空蒸着法やEB法、スパッタ法等の薄膜形成法の他に、MgOの前駆体である有機材料を用いた印刷法（厚膜形成法）等によって行うことができる。このうち印刷法では、例えば特開平4-10330号公報に開示されているように、液体の有機材料をガラス材料と混合し、これをパネルガラス表面にスピンコートし、600℃
20 付近で焼成することによりMgOを結晶化させて保護層を形成する。印刷法は真空蒸着法やEB法、スパッタ法に比べ、工程が比較的簡単で低コストで行えるメリットがあり、また真空プロセスを用いなくてもよいので、スループットの面からも優れている。

しかしながら、厚膜形成法で形成した保護層は、薄膜形成法において
25 真空プロセスで形成した保護層と比較すると、放電開始電圧 V_f を低減させる効果には大差がないが、PDP駆動時において放電セルごとに放電バラツキを生じやすい。この放電バラツキはいわゆる「黒ノイズ」を発生し、良好な画像表示性能が得られにくい原因ともなるので、改善が望まれる問題である。黒ノイズは、点灯すべき放電セル（選択された放電

セル) が点灯しない現象であり、画面のうちの点灯領域と非点灯領域との境界で生じ易い。表示電極の長手方向に沿った1つのライン、又は隣接する2つ隔壁の長手方向に沿った1つの列における複数の選択セルの全てが点灯しないというものではなく、発生部位が点在することから、

5 黒ノイズの原因はアドレス放電が生じないか、又は生じても強度が足りないという現象から生じていると考えられる。この原因としては、酸化マグネシウムから放出される電子と関係が深いことがわかっている。

また、PDPの放電バラツキに関する問題は、厚膜形成法を用いて保護層を形成する場合に限らず、薄膜形成法でも酸素欠損部分の少ない(すなわち酸素リッチな)MgOによって保護層が形成されると生じやすいので、厚膜・薄膜いずれの形成方法で成膜する場合においても早急な解決が求められている。

10

本発明はこのような課題に鑑みてなされたものであって、比較的低コストでありながら効率よく放電開始電圧 V_f と放電バラツキの発生をともに低減して駆動することにより、優れた画像表示性能を発揮できるPDPと、その製造方法を提供することにある。

15

発明の開示

上記課題を解決するために、本発明は、保護層が形成された第1基板が、放電空間を介して第2基板と対向配置され、前記両基板周囲が封着されてなるプラズマディスプレイパネルであって、保護層の表面には、互いに電子放出特性の異なる第1の材料と第2の材料が、それぞれ前記放電空間に露出し、且つ、第1の材料と第2の材料の少なくとも一方が分散して存在するものとした。

20

ここで、前記第1の材料は第1の結晶体であり、前記第2の材料は第2の結晶体であって、前記保護層の表面において、第1の結晶体中に第2の結晶体が分散されている構成とすることもできる。

25

この場合、前記第2の結晶体は、前記第1の結晶体よりも高純度であることが望ましい。

また本発明は、前記保護層は主として酸化マグネシウムからなり、前記第 2 の結晶体は酸化マグネシウムの結晶微粒子からなるものとすることができる。

5 一方前記第 1 の結晶体は、酸化マグネシウム前駆体を焼成して得ることができる。

このような本発明によれば、例えば保護層の放電開始電圧 V_f の低減特性は、第 1 の結晶体としての酸化マグネシウム結晶体と、第 2 の結晶体としての酸化マグネシウム結晶微粒子の双方によって発揮される。

すなわち PDP 駆動時において、放電空間内部で発生した電界により
10 放電ガスが励起され、放電ガス中の希ガス原子が保護層表面に近づくと、いわゆるオージェプロセスが生じ、保護層中の価電子帯における電子が遷移し、これによって保護層中の別の電子が放電空間へポテンシャル放出される。その結果、良好に二次電子放出特性が発揮されるので、放電開始電圧 V_f が低減される。この保護層による電子のポテンシャル放出
15 は、酸化マグネシウム結晶体の電子放出特性が多少悪くても、保護層に求められる性能として十分な二次電子放出特性 (γ) を得ることができる。このことから本発明の酸化マグネシウム結晶体には、厚膜形成法による塗布工程で保護層を作製する場合に用いられる低コストな酸化マグネシウム前駆体を利用しても、十分な効果が得られる。

20 次に、保護層の放電バラツキの抑制に関する特性は、高純度結晶構造を有することにより電子放出特性に優れる酸化マグネシウム結晶微粒子によって発揮される。すなわち放電空間内で電界が発生すると、これにともなう真空紫外線 (VUV) によって、まずマグネシウム結晶微粒子中の電子が酸素欠損部分に遷移する。そして、当該酸素欠損部分における
25 電子のエネルギー差により酸素欠損部分が発光中心として作用し、可視光を発光する。この可視光発光にともない、マグネシウム結晶微粒子中で価電子帯から伝導帯近傍のエネルギーレベル (不純物準位) まで励起される電子が発生する。この不純物準位の電子が増えることで保護層のキャリア濃度が向上し、インピーダンス制御がなされる。この結果、PDP

駆動時の放電バラツキが抑制され、PDP の放電確率を向上させるとともに、黒ノイズの発生を防止して、良好な画像表示性能を発揮することができる。

5 図面の簡単な説明

図 1 は、実施の形態 1 における PDP の主要構成を示す部分断面図である。

図 2 は、PDP の駆動プロセス例を示す図である。

図 3 は、実施の形態 1 の保護層の構成を示す図である

10 図 4 は、実施の形態 2 の保護層の構成を示す図である。

図 5 は、保護層のエネルギーバンド図である。

図 6 は、実施の形態 3 における PDP の主要構成を示す部分断面図である。

図 7 は、MgO と Al の光電子分光データを示す図である。

15 図 8 は、酸化マグネシウムと Al のエネルギーバンドである。

図 9 は、酸化マグネシウムとその他の材料の複合体もしくは複合材料からなる保護層の構成図である。

図 10 は、実施の形態 4 における PDP の主要構成を示す部分断面図である。

20

発明を実施するための好ましい形態

1.実施の形態 1

1-1.PDP の構成

25 図 1 は、本発明の実施の形態 1 に係る AC 型 PDP1 の主要構成を示す部分的な断面斜視図である。図中、z 方向が PDP1 の厚み方向、xy 平面が PDP1 のパネル面に平行な平面に相当する。PDP1 は、ここでは一例として 42 インチクラスの NTSC 仕様に合わせた仕様になっているが、本発明はもちろん XGA や SXGA 等、その他の仕様・サイズに適用してもよい。

図 1 に示すように、PDP1 の構成は、互いに主面を対向させて配設されたフロントパネル 10 およびバックパネル 16 に大別される。

フロントパネル 10 の基板となるフロントパネルガラス 11 には、その一方の主面に複数対の表示電極 12、13（スキャン電極 12、サステイン電極 13）が形成されている。各表示電極 12、13 は、ITO または SnO_2 等の透明導電性材料からなる帯状の透明電極 120、130（厚さ $0.1\mu\text{m}$ 、幅 $150\mu\text{m}$ ）に対して、Ag 厚膜（厚み $2\mu\text{m}\sim 10\mu\text{m}$ ）、アルミニウム（Al）薄膜（厚み $0.1\mu\text{m}\sim 1\mu\text{m}$ ）または Cr/Cu/Cr 積層薄膜（厚み $0.1\mu\text{m}\sim 1\mu\text{m}$ ）等からなるバスライン 121、131（厚さ $7\mu\text{m}$ 、幅 $95\mu\text{m}$ ）が積層されてなる。このバスライン 121、131 によって透明電極 120、130 のシート抵抗が下げられる。

表示電極 12、13 を配設したフロントパネルガラス 11 には、当該ガラス 11 の主面全体にわたって、酸化鉛（ PbO ）または酸化ビスマス（ Bi_2O_3 ）または酸化燐（ PO_4 ）を主成分とする低融点ガラス（厚み $20\mu\text{m}\sim 50\mu\text{m}$ ）の誘電体層 14 が、スクリーン印刷法等によって形成されている。誘電体層 14 は、AC 型 PDP 特有の電流制限機能を有しており、DC 型 PDP に比べて長寿命化を実現する要素になっている。誘電体層 14 の表面には、厚さ約 $1.0\mu\text{m}$ の保護層 15 が順次コートされている。

ここにおいて本実施の形態 1 では、その主な特徴として、保護層 15 が互いに電子放出特性の異なる二種類の構造を持つ酸化マグネシウムから構成されている。すなわち図 3 の保護層正面図に示すように、後述の放電空間 24 に露出する保護層 15 の表面部分には、有機材料の前駆体を焼成してなる第 1 の材料として酸化マグネシウム結晶体 15A と、前記前駆体の焼成前に予め結晶化されてなる第 2 の材料として酸化マグネシウム結晶微粒子 15B が、分散して存在する。

この構成によれば、PDP 駆動時には酸化マグネシウム結晶体 15A および酸化マグネシウム結晶微粒子 15B の両方で放電開始電圧 V_f の低減が良好になされる一方、酸化マグネシウム結晶微粒子 15B によって、保護層 15 の電子放出特性が発揮されるので、良好な画像表示性能がなさ

れることとなる。この効果の詳細については後述する。

バックパネル 16 の基板となるバックパネルガラス 17 には、その一方の主面に Ag 厚膜（厚み $2\mu\text{m}\sim 10\mu\text{m}$ ）、アルミニウム（Al）薄膜（厚み $0.1\mu\text{m}\sim 1\mu\text{m}$ ）または Cr/Cu/Cr 積層薄膜（厚み $0.1\mu\text{m}\sim 1\mu\text{m}$ ）等からなる幅 $60\mu\text{m}$ の複数のアドレス電極 18 が、x 方向を長手方向として y 方向に一定間隔毎（ $360\mu\text{m}$ ）でストライプ状に並設され、このアドレス電極 18 を内包するようにバックパネルガラス 17 の全面にわたって厚さ $30\mu\text{m}$ の誘電体膜 19 がコートされている。誘電体膜 19 の上には、さらに隣接するアドレス電極 18 の間隙に合わせて隔壁 20（高さ約 $150\mu\text{m}$ 、幅 $40\mu\text{m}$ ）が配設され、隣接する隔壁 20 によってサブピクセル SU が区画され、x 方向での誤放電や光学的クロストークの発生を防ぐ役割をしている。そして隣接する 2 つの隔壁 20 の側面とその間の誘電体膜 19 の面上には、カラー表示のための赤色（R）、緑色（G）、青色（b）のそれぞれに対応する蛍光体層 21～23 が形成されている。

なお、誘電体膜 19 を用いずにアドレス電極 18 を直接蛍光体層 21～23 で内包するようにしてもよい。

フロントパネル 10 とバックパネル 16 は、アドレス電極 18 と表示電極 12、13 の互いの長手方向が直交するように対向させながら配置され、両パネル 10、16 の外周縁部をガラスフリットで封着されている。この両パネル 10、16 間には He、Xe、Ne などの不活性ガス成分からなる放電ガス（封入ガス）が所定の圧力（通常 $53.2\text{kPa}\sim 79.8\text{kPa}$ 程度）で封入されている。

隣接する隔壁 20 間は放電空間 24 であり、隣り合う一対の表示電極 12、13 と 1 本のアドレス電極 18 が放電空間 24 を挟んで交叉する領域が、画像表示にかかるサブピクセル SU に対応する。セルピッチは x 方向が $1080\mu\text{m}$ 、y 方向が $360\mu\text{m}$ である。隣り合う RGB3 つのサブピクセル SU で 1 画素（ $1080\mu\text{m}\times 1080\mu\text{m}$ ）が構成される。

1-2.PDP の基本動作

上記構成の PDP1 は、表示電極 12、13 およびアドレス電極 18 に給電

する不図示の駆動部によって駆動される。画像表示のための駆動時には、一対の表示電極 12、13 の間隙には数十 kHz～数百 kHz の AC 電圧が印加され、サブピクセル SU 内で放電を発生させ、励起された Xe 原子からの紫外線によって蛍光体層 21～23 を励起し可視光発光させる。

- 5 このとき上記駆動部では、各セルの発光を ON/OFF の 2 値制御によって制御し、階調表現するために、外部からの入力画像である時系列の各フレーム F を、例えば 6 個のサブフレームに分割する。各サブフレームにおける輝度の相対比率が例えば 1 : 2 : 4 : 8 : 16 : 32 となるように重み付けをして、各サブフレームのサステイン（維持放電）の発光回数を
10 設定する。

ここで図 2 は、本 PDP1 の駆動波形プロセスの一例である。ここではフレーム中の第 m 番目のサブフレームの駆動波形を示している。当図 2 が示すように、各サブフレームには、初期化期間、アドレス期間、放電維持期間、消去期間がそれぞれ割り当てられる。

- 15 初期化期間とは、それ以前のセルの点灯による影響（蓄積された壁電荷による影響）を防ぐため、画面全体の壁電荷の消去（初期化放電）を行う期間である。当図 2 に示す波形例では、すべての表示電極 12、13 に放電開始電圧 V_f を超える正極性の下りランプ波形のリセットパルス
20 を印加する。これとともに、バックパネル 16 側の帯電とイオン衝撃を防ぐために、すべてのアドレス電極 18 に正極性パルスを印加する。印加パルスの立ち上がり立ち下りの差動電圧によって、すべてのセルで弱い面放電である初期化放電が生じ、すべてのセルにおいて壁電荷が蓄積され、画面全体が一様な帯電状態となる。

- アドレス期間は、サブフレームに分割された画像信号に基づいて選択
25 されたセルのアドレッシング（点灯/不点灯の設定）を行う期間である。当該期間では、スキャン電極 12 を接地電位に対して正電位にバイアスし、すべてのサステイン電極 13 を負電位にバイアスする。この状態で、パネル上部最先におけるライン（一対の表示電極に対応する横一列のセル）から 1 ラインずつ順に各ラインを選択し、該当するスキャン電極 12

に負極性のスキャンパルス印加する。また、点灯すべきセルに対応したアドレス電極 18 に対して、正極性のアドレスパルス印加する。これにより前記初期化期間での弱い面放電を受け継ぎ、点灯すべきセルのみでアドレス放電が行われ、壁電荷が蓄積される。

- 5 放電維持期間は、階調準位に応じた輝度を確保するために、アドレス放電により設定された点灯状態を拡大して放電維持する期間である。ここでは不要の放電を防止するため、全てのアドレス電極 18 を正極性の電位にバイアスし、全てのサステイン電極 13 に正極性のサステインパルス印加する。その後、スキャン電極 12 とサステイン電極 13 とに対して交互にサステインパルス印加し、所定期間放電を繰り返す。

10 消去期間では、スキャン電極 12 に漸減パルス印加し、これによって壁電荷を消去させる。

- なお初期化期間およびアドレス期間の長さは、輝度の重みに関わらず一定であるが、放電維持期間の長さは輝度の重みが大きいほど長い。つまり、各サブフレームの表示期間の長さは互いに異なる。

- 15 PDP1 ではサブフレームで行われる各放電によって、Xe に起因する、147nm に鋭いピークを有する共鳴線と、173nm を中心とする分子線からなる真空紫外線が発生する。この真空紫外線が各蛍光体層 21~23 に照射され、可視光が発生する。そして、RGB 各色ごとのサブフレーム単位組み合わせにより、多色・多階調表示がなされる。

1-3.実施の形態 1 の効果について

- 20 PDP の放電特性は、放電空間 24 で放電ガスと接触する保護層 15 の放電特性に大きく依存している。保護層に求められる特性としては、放電開始電圧 V_f の低減特性（二次電子放出特性）と、放電バラツキの抑制に関する特性に分けられ、当該両特性が優れるほど PDP の画像表示性能が実現される。

ここで本実施の形態 1 における PDP1 では、上記両特性をともに有効に確保するため、図 3 の保護層正面図に示すように、少なくとも放電空間 24 に露出する保護層 15 の表面に、互いに異なる電子放出特性を持つ

酸化マグネシウム結晶体 15A と、酸化マグネシウム結晶微粒子 15B が分散して存在するように構成している。酸化マグネシウム結晶体 15A は、有機材料の酸化マグネシウム前駆体を焼成して構成される。一方、酸化マグネシウム結晶微粒子 15B は、前記前駆体の焼成前に予め結晶化されたものであって、酸化マグネシウム結晶体 15A より高純度結晶構造を有している。ここで図 3 の保護層 15 の構成では、第 1 結晶体としての酸化マグネシウム結晶体 15A 中に、第 2 結晶体としての酸化マグネシウム結晶微粒子 15B が分散して存在するように構成されている。

このような構成によれば、まず保護層 15 の放電開始電圧 V_f の低減特性は、酸化マグネシウム結晶体 15A と、酸化マグネシウム結晶微粒子 15B の双方によって発揮される。

すなわち PDP 駆動時において、放電空間 24 内部で発生した電界により放電ガスが励起され、放電ガス中の Ne^+ が保護層表面に近づくと、いわゆるオージェプロセスが生じ、保護層中の価電子帯における電子が、Ne の最外殻に遷移する。そしてこの電子の遷移にともない、保護層中の別の電子が前記 Ne^+ へ遷移した電子のエネルギー変化分を受けて、放電空間 24 へポテンシャル放出される。その結果、良好に二次電子放出特性が発揮されるので、放電開始電圧 V_f が低減される。この保護層による電子のポテンシャル放出は、保護層の価電子帯上端よりも Ne^+ の最外殻電子レベルがかなり深いところにあるので、酸化マグネシウム結晶体 15A の電子放出特性が多少悪くても（言い換えれば結晶中に不純物が多少混入していても）、保護層に求められる性能として十分な二次電子放出特性（ γ ）を得ることができる。このことから、本実施の形態 1 の酸化マグネシウム結晶体 15A には、厚膜形成法による塗布工程で保護層を作製する場合に用いられる酸化マグネシウム前駆体を利用しても、十分な効果が得られる。この厚膜形成法によれば、酸化マグネシウム前駆体中の炭素成分等の不純物が若干保護層中に残存することがあるが、その場合でも本実施の形態 1 では良好な性能の保護層を形成することができる。そのため、保護層の製造工程自体を真空プロセス等の大がかりな設

備による薄膜形成法に依存しなくても、低コストかつ優れたスループットで製造することができるといった厚膜形成法のメリットを有効に活かすことができるのである。

5 なお、前記保護層の価電子帯からの電子の遷移は、 Ne^+ 以外の放電ガス成分との間でも生じるが、 Ne^+ が最も効果が高い。これは、保護層の価電子帯上端に対する Ne^+ の最外殻電子レベルが十分に低いためである。

10 次に、保護層 15 の放電バラツキの抑制に関する特性は、高純度結晶構造を有することにより電子放出特性に優れる酸化マグネシウム結晶微粒子 15B によって発揮される。

15 具体的には、図 5 の保護層のエネルギーバンド図に示すように、PDP 駆動時において放電空間 24 内で電界が発生すると、これにともなう真空紫外線 (VUV) によって、まずマグネシウム結晶微粒子 15B 中の電子が酸素欠損部分に遷移する。そして、当該酸素欠損部分における電子のエネルギー差 (E_2-E_1) により酸素欠損部分が発光中心として作用し、
20 可視光を発光する。この可視光発光にともない、マグネシウム結晶微粒子 15B 中で価電子帯 E_v から伝導帯 E_c 近傍のエネルギーレベル (不純物準位 E_3) まで励起される電子が発生する。この不純物準位 E_3 の電子が増えることで保護層 15 のキャリア濃度が向上し、インピーダンス制御がなされる。この結果、PDP 駆動時の放電バラツキが抑制され、PDP の放電確率を向上させるとともに、黒ノイズの発生を防止することができる。保護層 15 の放電バラツキの抑制に関する特性は、半導体におけるキャリアドープに近い現象であるため、これをなすための保護層 15
25 に不純物が少なく、配向性に優れる等、高い結晶性が求められる。そこで本実施の形態 1 では、放電バラツキの抑制効果を良好に得るために、電子放出特性に優れる (すなわち前記高い結晶性の) 酸化マグネシウム結晶微粒子 15B を用い、これに放電バラツキを抑制し、黒ノイズの発生を防止するための機能を分担させるようにしている。マグネシウム結晶微粒子 15B 中では酸素欠損部分を多く得るために酸素リッチな構成と

このように本実施の形態 1 では、放電空間 24 に臨む保護層 15 の表面部分に、電子放出特性の異なる複数の絶縁体（結晶体）15A、15B を露出させ、当該個々の結晶体 15A、15B で放電特性を機能分担しているの
5 で、放電特性の制御の自由度が大きくなるとともに、セル設計や製造方法の自由度も拡大できるといったメリットが得られる。

また本実施の形態 1 の PDP1 では、駆動回路に高価な高耐圧トランジスタを用いなくても放電開始電圧 V_f を低減し、且つ放電バラツキの発生を抑制して黒ノイズの発生を防止することで良好な画像性能を得ること
10 が可能となっている。

なお、放電空間 24 に臨む保護層 15 の表面部分に露出させる絶縁体（結晶体）は、酸化マグネシウムに限定するものではなく、これ以外の絶縁体（例えば $MgAlO$ 、 BaO 、 CaO 、 ZnO 、 SrO 等）のうち一種以上を用いることができる。

さらに、本実施の形態 1 の保護層 15 を形成する方法としては、酸化マグネシウム前駆体に酸化マグネシウム結晶微粒子を添加させ、これを塗布・焼成する方法に限定するものではなく、液体材料同士を混合してもよいし、パターニングやパターニング後のエッチバックなどの方法を取ってもよい。

20 1-4. 保護層に不純物をドーピングする場合について

上記実施の形態 1 の保護層 15 は、そのままの構成でも優れた効果を得ることができるが、以下の工夫を行うことで、さらにその効果を高めることができる。

一例を挙げると、少なくとも酸化マグネシウム結晶微粒子 15B に Cr
25 を $1E-17/cm^3$ 程度以上の濃度でドーピングすると、PDP 駆動時には本来から存在する酸素欠損部分に加え、波長約 700nm の可視光発光を生じる発光中心が形成され、豊富な可視光発光とともに伝導帯近傍に励起される電子数が増えるので、放電バラツキを抑制する効果をより高めることができる（C.C.Chao, J. Phys. Chem. Solids, 32 2517(1971)や、M.

Maghrabi et al, NIM B191(2002)181 を参照)。

また、少なくとも酸化マグネシウム結晶微粒子 15B に Si、H 等を
1E-16/cm³ 程度以上の濃度で添加すると、これらは伝導帯近傍に励起さ
れた電子のリザーバーとして作用し、発光中心の可視光発光が長寿命化
5 するので、この場合も放電バラツキを抑え、黒ノイズの発生を低減する
効果が高くなる。

少なくとも酸化マグネシウム結晶微粒子 15B に Si を添加する方法と
しては、前記 15A、15B の基本構成を焼成によって得た後、シランやジ
シランを含むガスをプラズマ状態にした雰囲気中で処理しても良いし、
10 Si 原子もしくは Si を含む分子をドーピングによって注入してもよい。
また、事前に Si を添加した酸化マグネシウム結晶微粒子を用いても良い。

保護層に対する H の添加方法としては、保護層表面を H₂ 雰囲気中で
アニール処理しても良いし、H₂ を含むガスをプラズマ状態にした雰
15 囲気中に保護層を載置することにより処理してもよい。また、事前に H を添
加した酸化マグネシウム結晶微粒子を用いても良い。

PDP の全体的な製造方法については以下に説明する。

2.PDP の製造方法

ここでは実施の形態 1 の PDP1 の製造方法について、その一例を説明
する。

20 なお当該製造方法は、その他の実施の形態の PDP1 の製造方法として
も適用可能である。

2-1.フロントパネルの作製

厚さ約 2.6mm のソーダライムガラスからなるフロントパネルガラス
の面上に表示電極を作製する。ここでは印刷法によって表示電極を形成
25 する例を示すが、これ以外にもダイコート法、ブレードコート法等で形
成することができる。

まず、ITO（透明電極）材料を所定のパターンでフロントパネルガラ
ス上に塗布する。これを乾燥させる。

一方、フォトリソ法を用いて、金属（Ag）粉末と有機ビヒクルに感

これを前記透明電極材料の上に重ねて塗布し、形成する表示電極のパターンを有するマスクで覆う。そして、当該マスク上から露光し、現像・焼成（590～600℃程度の焼成温度）する。これにより透明電極上にバスラインが形成される。このフォトマスク法によれば、従来は 100 μm の線幅が限界とされていたスクリーン印刷法に比べ、30 μm 程度の線幅までバスラインを細線化することが可能である。なお、このバスラインの金属材料としては、この他に Pt、Au、Ag、Al、Ni、Cr、また酸化錫、酸化インジウム等を用いることができる。

また、前記電極は上記方法以外にも、真空蒸着法、スパッタリング法などで電極材料を成膜したのち、エッチング処理して形成することも可能である。

次に、形成した表示電極の上から、軟化点が 550℃～600℃の酸化鉛系あるいは酸化ビスマス系の誘電体ガラス粉末とブチルカルビトールアセテート等からなる有機バインダーを混合したペーストを塗布する。そして、550℃～650℃程度で焼成し、誘電体層を形成する。

次に、誘電体層の表面に、本発明の特徴である保護層を、印刷法（厚膜形成法）を用いて形成する。具体的には、予め形成された第 1 の結晶体材料としての平均粒径 50nm の酸化マグネシウム結晶微粒子（宇部興産製）を、第 2 の結晶体材料として液体状有機材料である酸化マグネシウム前駆体（マグネシウムジエトキシド、ナフテン酸マグネシウム、オクチル酸マグネシウム、マグネシウムジメトキシドの中から選ばれた 1 種以上）と混合する。これをスピコート法等により、前記誘電体層の上から厚み約 1 μm で塗布する。印刷法としては、この他にダイコート法、ブレードコート法等で形成することができる。塗布工程が完了したら、次に約 600℃で焼成し、材料中に含まれている炭素成分などの不純物を十分除去することにより、実施の形態 1 の保護層が形成される。酸化マグネシウム前駆体としては前記以外のものを用いてもよい。

また上記例では、一種類の材料からなる酸化マグネシウム結晶微粒子を用いたが、保護層における粒子密度を確保するため等の目的で、適宜

複数種類の酸化マグネシウム結晶微粒子を用いても良い。酸化マグネシウム結晶微粒子のサイズは、保護層の厚さに合わせて適宜決定すればよいが、現在の保護層の設計（厚さ 700nm から 1 μ m 程度）では、数十 nm から数百 nm のサイズの微粒子を用いるのが良い。

本発明の保護層は、厚膜形成法によって作製しても良好な性能が得られる点で優れているが、製造コストおよびスループットが許容範囲にあれば、薄膜形成法によって形成してもよい。この場合、蒸発源として二種類の異なる材料を用い、通常の真空プロセスを行うという方法がある。

これでフロントパネルが作製される。

2-2. バックパネルの作製

厚さ約 2.6mm のソーダライムガラスからなるバックパネルガラスの表面上に、スクリーン印刷法により Ag を主成分とする導電体材料を一定間隔でストライプ状に塗布し、厚さ約 5 μ m のアドレス電極を形成する。ここで、作製する PDP1 を例えば 40 インチクラスの NTSC 規格もしくは VGA 規格とするためには、隣り合う 2 つのアドレス電極の間隔を 0.4mm 程度以下に設定する。

続いて、アドレス電極を形成したバックパネルガラスの面全体にわたって鉛系ガラスペーストを厚さ約 20~30 μ m で塗布して焼成し、誘電体膜を形成する。

次に、誘電体膜と同じ鉛系ガラス材料を用いて、誘電体膜の上に、隣り合うアドレス電極の間毎に高さ約 60~100 μ m の隔壁を形成する。この隔壁は、例えば上記ガラス材料を含むペーストを繰り返しスクリーン印刷し、その後焼成して形成できる。なお、本発明では隔壁を構成する鉛系ガラス材料に Si 成分が含まれていると、保護層のインピーダンス上昇を抑制する効果が高まるので望ましい。この Si 成分はガラスの化学組成に含まれていても、ガラス材料に添加してもよい。

隔壁が形成できたら、隔壁の壁面と、隔壁間で露出している誘電体膜の表面に、赤色（R）蛍光体、緑色（G）蛍光体、青色（b）蛍光体のい

ずれかを含む蛍光インクを塗布し、これを乾燥・焼成してそれぞれ蛍光体層とする。

RGB 各色蛍光の化学組成は、例えば以下の通りである。

赤色蛍光体； $Y_2O_3;Eu^{3+}$

5 緑色蛍光体； $Zn_2SiO_4:Mn$

青色蛍光体； $BaMgAl_{10}O_{17};Eu^{2+}$

各蛍光体材料は、平均粒径 $2.0\mu m$ のものを使用できる。これをサーバー内に 50 質量%の割合で入れるとともに、エチルセルローズ 1.0 質量%、溶剤（ α -ターピネオール）49 質量%を投入し、サンドミルで攪拌混合して、 $15 \times 10^{-3} Pa \cdot s$ の蛍光体インクを作製する。そして、これをポンプにて径 $60\mu m$ のノズルから隔壁 20 間に噴射させて塗布する。このとき、パネルを隔壁 20 の長手方向に移動させ、ストライプ状に蛍光体インクを塗布する。その後は $500^\circ C$ で 10 分間焼成し、蛍光体層 21～23 を形成する。

15 以上でバックパネルが完成される。

なおフロントパネルガラスおよびバックパネルガラスをソーダライムガラスからなるものとしたが、これは材料の一例として挙げたものであって、これ以外の材料でもよい。

2-3.PDP の完成

20 作製したフロントパネルとバックパネルを、封着用ガラスを用いて貼り合わせる。その後、放電空間の内部を高真空（ $1.0 \times 10^{-4} Pa$ ）程度に排気し、これに所定の圧力（ここでは $66.5kPa \sim 101kPa$ ）で Ne-Xe 系や He-Ne-Xe 系、He-Ne-Xe-Ar 系などの放電ガスを封入する。本発明の保護層によるポテンシャル放出（二次電子放出特性）に関する効果を有効に得るためには、放電ガスに Ne が含まれるようにするとよい。

25 以上で PDP1 が完成する。

3.実施の形態 2

次に、実施の形態 2 の PDP の構成を図 4 を用いて説明する。

前記実施の形態 1 では、保護層 15 として酸化マグネシウム結晶体 15A

に示す本実施の形態 2 の保護層 15 は、前記酸化マグネシウム結晶微粒子 15B の代わりに、炭素結晶体であるカーボンナノチューブ (CNT) 15C を放電空間 24 に露出するように、酸化マグネシウム結晶体 15A 中に分散させた構成としている。この酸化マグネシウム結晶体 15A と CNT15C
5 によって、保護層 15 に求められる放電開始電圧 V_f の低減特性と、放電バラツキの抑制特性をそれぞれ機能分担させている。当該保護層 15 は、例えば酸化マグネシウム前駆体を含む有機材料に CNT を添加し、これをフロントパネルに塗布・焼成することで形成できる。

このような構成の PDP によれば、PDP 駆動時において、まず酸化マグネシウム結晶体 15A が実施の形態 1 と同様の効果を奏する。CNT15C
10 は電子放出特性に優れているので、酸化マグネシウム結晶体 15A とともに保護層 15 の二次電子放出係数 (γ) が向上し、放電開始電圧 V_f が良好に低減される。

一方、CNT15C は保護層 15 の電子放出量を増大させる働きがある。
15 これにより PDP 駆動時には保護層 15 のキャリア濃度が向上するので、結果としてインピーダンス制御が行われ、放電バラツキが抑制される。本発明ではこのように、酸化マグネシウムと CNT を利用する構成としてもよい。

なお、ここでは炭素結晶体として CNT を用いる構成を示したが、本
20 発明ではこの他にフラーレン等、電子放出特性に優れる炭素結晶体を用いても同様の効果が奏される。

4. その他の事項

上記実施の形態 1、2 では、PDP の構成例を示したが、本発明はこれに限定するものではなく、例えば放電ガスが封入された放電空間と、当該放電空間に臨むように配された保護層とを有し、上記放電空間内でプラズマを発生して発光する構成の放電発光素子に適用してもよい。具体的な放電発光素子の構成としては、例えば実施の形態 1 における PDP1
25 の単セル構造体とすることができる。

5. 実施の形態 3

5-1.保護層の構成

次に、実施の形態 3 の PDP1 について図 6 の PDP 部分断面図を用いて説明する。

図 1 (a) は、x 方向断面図、図 1 (b) は図 1 (a) の a-a' で切断した y 方向断面図である。当該 PDP1 の基本的な構成は実施の形態 1、2 と同様であり、特徴部分の保護層 15 の構成だけが異なる。

すなわち実施の形態 3 の PDP1 では少なくとも保護層 15 の表面部分において、図 1 (a)、(b) に示すように、第 1 の材料として酸化マグネシウムからなるベースに、第 2 の材料として前記酸化マグネシウムより高いフェルミエネルギーを有する島状金属材料からなる島状金属部 150 を、放電空間 24 に臨むように配設した構成としている。具体的には、島状金属部 150 は一対の表示電極 12、13 にパネル厚み方向 (z 方向) で重なる位置 (ここではスキャン電極 12 の直下) に配設した構成としている。

島状金属材料には、仕事関数が 5eV 以下で、かつ耐スパッタ性に優れたものが望ましく、例えば Fe、Al、Mg、Ta、Mo、W、Ni の中から選ばれた材料が好ましい。上記例では Al を用いている。

なお島状金属部の代わりに、前記酸化マグネシウムより高いフェルミエネルギーを有する材料として、この他に各種絶縁材料、半導体材料等を選び、これを島状に形成して用いることもできる。

5-2.実施の形態 3 の効果

図 7 は、MgO 膜上に上記島状金属部を形成し、これについて測定した光電子分光データである。当図 7 中、実施の形態 3 の保護層に関するデータが 2A に相当し、比較例 (通常の MgO 膜からなる保護層) に関するデータが 2B に相当する。島状金属部としては、セル開口部面積の 10 分の 1 程度としている。本発明の島状金属部は、空間周期がセルサイズの 10 分の 1 以下程度になるよう設定するのが望ましい。

このデータから明らかなように、実施の形態 3 の性能を示す 2A のデータでは、島状金属部が微小な領域であるにもかかわらず、電子放出が

Al の仕事関数である 4.2eV で立ち上がっている。一方、比較例のデータにおける電子放出の立ち上がりは、5.0eV 程度であり、真空準位から測った MgO 膜のフェルミレベル（エネルギー）までのエネルギーに相当する。このことから実施の形態 3 では、MgO 膜自体で放電開始電圧 Vf
5 を抑制しつつ、島状金属部によって保護層の電子放出特性を向上させ、放電バラツキを抑制させる効果が期待できる。

Al と MgO のエネルギーバンドを図 8 に示す。当図に示されるエネルギー関係から、実施の形態 3 の保護層 15 において、酸化マグネシウム表面に島状金属部 150 を設けることにより壁電荷が充分保持できるよう
10 になり、かつ 2 次電子放出量の多い特性が得られることが分かる。これは PDP の保護層として好ましい特性であると言える。

ここで島状金属部 150 は、それぞれの島状金属部 150 が互いに孤立して絶縁状態になるよう設ける必要があるが、セル放電等に必要な壁電荷が抜けない程度の個数、大きさ、形状、形成場所であれば問題はない。

15 また、前記島状金属部 150 を配置する位置は、PDP 駆動時に発生する放電によって、スパッタリングが顕著になされる保護層表面領域を避け、且つ、画像表示のための可視光発光を遮蔽することのないような位置が望ましい。この理由から、本実施の形態 3 では、図 6 に示すように、表示電極直下、例えばスキャン電極 12 上のバスライン 12114 の直下が適
20 している。

このような実施の形態 3 では、本願発明者らの実験によれば、従来のものに比べて放電開始電圧 Vf を 20% 程度低減でき、かつ壁電荷の保持力については従来のものと遜色なく、黒ノイズにおいても従来に比べて生じにくい良好な PDP を実現できることが分かっている。

25 6. 実施の形態 4

次に、実施の形態 4 の PDP1 について図 9 の保護層正面図を用いて説明する。図 9 (a) および図 9 (b) はそれぞれ保護層の別構成を示す。

当該 PDP1 の基本的な構成は実施の形態 1~3 と同様であり、特徴部分の保護層 15 の構成だけが異なる。

図 9 (a) に示す構成例では、保護層 15 において、隣接する第 1 の材料としての酸化マグネシウム結晶粒 152 の結晶粒界 153 もしくはその近傍に、実施の形態 3 で説明した第 2 の材料として、MgO のフェルミエネルギーよりも高いフェルミエネルギーをもつ絶縁体もしくは半導体、もしくは金属を析出させ、保護層全体で複合体を形成する構成となっている。

このような保護層 15 は、Mg などの 650℃ 程度以下の融点を持つ金属材料を MgO 中で選択的に溶融させることで形成できる。

もちろん、上記結晶粒界 153 に析出させる金属としては Mg に限るものではなく、5eV 以下の仕事関数を持ち、かつ耐スパッタ性に優れたものが好ましい。上記金属材料は、例えば、Fe、Al、Ta、Mo、W、Ni の中から選ばれた 1 種以上であってもよい。

一方、図 9 (b) に示す構成例は、MgO の多結晶膜中において、酸化マグネシウム結晶粒 152 とともに、MgO のフェルミエネルギーよりも高いフェルミエネルギーをもつ絶縁体もしくは半導体、もしくは金属 (Fe) などの別の材料の結晶粒 154 を分散させたナノコンポジット複合材料からなる保護層 15 である。当該ナノコンポジット複合材料としては、例えば、Journal of the Ceramic Society of Japan 108 (9) (2000) p.781-784 に開示された技術で作製された MgO/Fe のナノコンポジット複合材料を用いてもよい。

上記結晶粒 154 に用いる金属としては Fe に限らず、5eV 以下の仕事関数を持ち、かつ耐スパッタ性に優れたものが好ましい。例えば、Mg、Al、Ta、Mo、W、Ni などを用いることが可能である。

図 10 (a)、(b) は、図 9 (a)、(b) に示したような複合体や複合材料を PDP の保護層 15 に適用させた具体的な構成を示している。図 10 (a) は、x 方向断面図、図 10 (b) は図 10 (a) の a-a' で切断した y 方向断面図である。当図 10 に示す構成では、前記複合体または複合材料からなる保護層領域を各サブピクセル SU (放電セル) 内で局所的に設けている。具体的には、複合体または複合材料からなる保護層領域は、前記

実施の形態 3 の島状金属部 150 と同様に、PDP 駆動時に発生する放電によって、スパッタリングが顕著になされる領域を避け、且つ、画像表示のための可視光発光を遮蔽することのないような位置に設けることが望ましい。この理由から図 10 (a)、(b) の構成例では、表示電極直下、例えばスキャン電極 12 上のバスライン 121 の直下に島状に局所的に設けている。

なお、実施の形態 4 では前記複合体または複合材料からなる保護層領域を局所的に設ける構成に限定するものではなく、保護層 15 全体を前記複合体または複合材料により構成してもよい。

10 実施の形態 4 では、発明者の実験によれば従来に比べて放電開始電圧 V_f を 20% 程度低減でき、かつ壁電荷の保持力については従来のもものと遜色なく、黒ノイズにおいても従来に比べて生じにくい良好な PDP を実現できることが明らかにされている。

15 産業上の利用可能性

本願発明は、テレビジョン、特に高精細な再現画像が可能なハイビジョンテレビに適用が可能である。

請求の範囲

1.

保護層が形成された第 1 基板が、放電空間を介して第 2 基板と対向配置され、前記両基板周囲が封着されてなるプラズマディスプレイパネル
5 であって、

保護層の表面には、

互いに電子放出特性の異なる第 1 の材料と第 2 の材料が、それぞれ前記放電空間に露出し、且つ、第 1 の材料と第 2 の材料の少なくとも一方が分散して存在することを特徴とするプラズマディスプレイパネル。

10 2.

前記第 1 の材料は第 1 の結晶体であり、前記第 2 の材料は第 2 の結晶体であって、

前記保護層の表面において、第 1 の結晶体中に第 2 の結晶体が分散されている構成であることを特徴とする請求の範囲 1 に記載のプラズマディスプレイパネル。
15

3.

前記第 2 の結晶体は前記第 1 の結晶体よりも高純度であることを特徴とする請求の範囲 2 に記載のプラズマディスプレイパネル。

4.

20 前記保護層は主として酸化マグネシウムからなり、

前記第 2 の結晶体は酸化マグネシウムの結晶微粒子からなることを特徴とする請求の範囲 2 に記載のプラズマディスプレイパネル。

5.

前記第 1 の結晶体は、酸化マグネシウム前駆体を焼成して得られたものであることを特徴とする請求の範囲 4 に記載のプラズマディスプレイパネル。
25

6.

前記第 2 の結晶体は、酸素リッチな酸化マグネシウムであることを特徴とする請求の範囲 4 に記載のプラズマディスプレイパネル。

7.

前記保護層のうち、少なくとも第 2 の結晶体中には、ケイ素、水素、クロムの中から選ばれた 1 種以上がドーピングされていることを特徴とする請求の範囲 2 に記載のプラズマディスプレイパネル。

5 8.

前記保護層のうち、少なくとも前記放電空間に臨む表面部分には、第 1 の材料として酸化マグネシウムが存在し、第 2 の材料としてフラーレンおよびカーボンナノチューブの少なくともいずれかが存在している構成であることを特徴とする請求の範囲 1 に記載のプラズマディスプレイパネル。

9.

前記保護層のうち、少なくとも前記放電空間に臨む表面部分には、前記第 2 の材料として、島状金属材料、酸化マグネシウムより高いフェルミエネルギーを持つ絶縁材料、酸化マグネシウムより高いフェルミエネルギーを持つ半導体材料、の少なくともいずれかが存在する構成であることを特徴とする請求の範囲 1 に記載のプラズマディスプレイパネル。

10.

前記島状金属材料は、5eV 以下の仕事関数を持つ金属材料より構成されていることを特徴とする請求の範囲 9 に記載のプラズマディスプレイパネル。

11.

前記島状金属材料は、Fe、Al、Mg、Ta、Mo、W、Ni の中から選ばれた材料より構成されていることを特徴とする請求の範囲 9 に記載のプラズマディスプレイパネル。

25 12.

前記第 1 基板では、当該基板表面と保護層との間に一対の表示電極が複数対にわたって配設されており、

前記島状金属材料は、前記一対の表示電極に対して保護層の厚み方向で重なる位置に配設されている

ことを特徴とする請求の範囲 9 に記載のプラズマディスプレイパネル。

13.

前記保護層のうち、少なくとも前記放電空間に臨む表面部分には、前記第 1 の材料として酸化マグネシウムが存在し、

且つ、前記第 2 の材料として、金属材料、酸化マグネシウムより高いフェルミエネルギーを持つ絶縁材料、酸化マグネシウムより高いフェルミエネルギーを持つ半導体材料、の少なくともいずれかが存在する構成であることを特徴とする請求の範囲 1 に記載のプラズマディスプレイパネル。

14.

前記第 2 の材料は、前記第 1 の材料である酸化マグネシウムの結晶粒界に存在することを特徴とする請求の範囲 13 に記載のプラズマディスプレイパネル。

15. 15.

前記金属材料は、5eV 以下の仕事関数を持つ金属材料であることを特徴とする請求の範囲 13 に記載のプラズマディスプレイパネル。

16.

前記金属材料は、Fe、Al、Mg、Ta、Mo、W、Ni の中から選ばれた材料より構成されていることを特徴とする請求の範囲 13 に記載のプラズマディスプレイパネル。

17.

前記保護層は、酸化マグネシウムを含んでなる第 1 の材料と、金属材料、酸化マグネシウムより高いフェルミエネルギーを持つ絶縁材料、酸化マグネシウムより高いフェルミエネルギーを持つ半導体材料、の少なくともいずれかを含んでなる第 2 の材料とが分散して構成されたナノコンポジット材料からなることを特徴とする請求の範囲 13 に記載のプラズマディスプレイパネル。

18.

前記プラズマディスプレイパネルでは、前記放電空間を区画するように複数の放電セルが形成されており、

前記第 2 の材料は、前記各放電セルの内部において、局所的に存在する構成であることを特徴とする請求の範囲 13 に記載のプラズマディスプレイパネル。

19.

放電空間と対向する基板表面に対して形成されるプラズマディスプレイパネル用保護膜であって、

前記保護膜のうち、少なくとも前記放電空間に臨む表面部分には、互いに電子放出特性の異なる第 1 の結晶体と、第 2 の結晶体が存在しており、前記第 1 の結晶体中に、前記第 2 の結晶体が分散している構成であることを特徴とするプラズマディスプレイパネル用保護膜。

20.

放電空間と対向する基板表面に対して形成されるプラズマディスプレイパネル用保護膜であって、

前記保護膜のうち、少なくとも前記放電空間に臨む表面部分には、酸化マグネシウムと、当該酸化マグネシウム中に分散して、フラーレンおよびカーボンナノチューブのうちの一種以上が存在している構成であることを特徴とするプラズマディスプレイパネル用保護膜。

20 21.

放電ガスが封入された放電空間と、当該放電空間に臨むように配された保護層とを有し、前記放電空間内でプラズマを発生して発光する放電発光素子であって、

前記保護層のうち、少なくとも前記放電空間に臨む表面部分には、互いに電子放出特性の異なる第 1 の結晶体と、第 2 の結晶体が存在しており、前記第 1 の結晶体中に、前記第 2 の結晶体が分散している構成であることを特徴とする放電発光素子。

22.

放電ガスが封入された放電空間と、当該放電空間に臨むように配され

た保護層とを有し、前記放電空間内でプラズマを発生して発光する放電発光素子であって、

前記保護層のうち、少なくとも前記放電空間に臨む表面部分には、酸化マグネシウムと、当該酸化マグネシウム中に分散して、フラーレンおよびカーボンナノチューブのうちの一種以上が存在している構成であることを特徴とする放電発光素子。

23.

第 1 基板表面に対して保護層を形成する保護層形成ステップと、保護層を形成した第 1 基板表面を、放電空間を介して第 2 基板と封着する封着ステップとを経るプラズマディスプレイパネルの製造方法であって、

前記保護層形成ステップは、第 1 の結晶体材料に第 2 の結晶体材料を混合してこれを第 1 基板表面に塗布する塗布ステップと、当該塗布ステップ後に焼成ステップとを有することを特徴とするプラズマディスプレイパネルの製造方法。

15 24.

前記第 1 の結晶体材料として酸化マグネシウム前駆体、第 2 の結晶体材料として酸化マグネシウム結晶微粒子をそれぞれ用いることを特徴とする請求の範囲 23 に記載のプラズマディスプレイパネルの製造方法。

25.

20 前記保護層形成ステップでは、第 1 の結晶体と第 2 の結晶体のうち、少なくとも第 2 の結晶体中に、ケイ素、水素、クロムの中から選ばれた 1 種以上をドーピングすることを特徴とする請求の範囲 23 または 24 に記載のプラズマディスプレイパネルの製造方法。

26.

25 前記保護層形成ステップにおいて、第 1 の結晶体と第 2 の結晶体のうち、少なくとも第 2 の結晶体中に水素をドーピングする方法として、アニール処理、プラズマドーピングのいずれかの方法を選択することを特徴とする請求の範囲 25 に記載のプラズマディスプレイパネルの製造方法。

27.

前記保護層形成ステップにおいて、第 1 の結晶体と第 2 の結晶体のうち、少なくとも第 2 の結晶体中にケイ素をドーピングする方法として、シランもしくはジシランによるプラズマドーピングを行うことを特徴とする請求の範囲 25 に記載のプラズマディスプレイパネルの製造方法。

5 28.

第 1 基板表面に対して保護層を形成する保護層形成ステップと、保護層を形成した第 1 基板表面を、放電空間を介して第 2 基板と封着する封着ステップとを経るプラズマディスプレイパネルの製造方法であって、

10 前記保護層形成ステップは、酸化マグネシウム前駆体材料にフラーレンおよびカーボンナノチューブの少なくともいずれかを混合し、これを第 1 基板表面に塗布する塗布ステップと、当該塗布ステップ後に焼成ステップとを有することを特徴とするプラズマディスプレイパネルの製造方法。

15

图 1

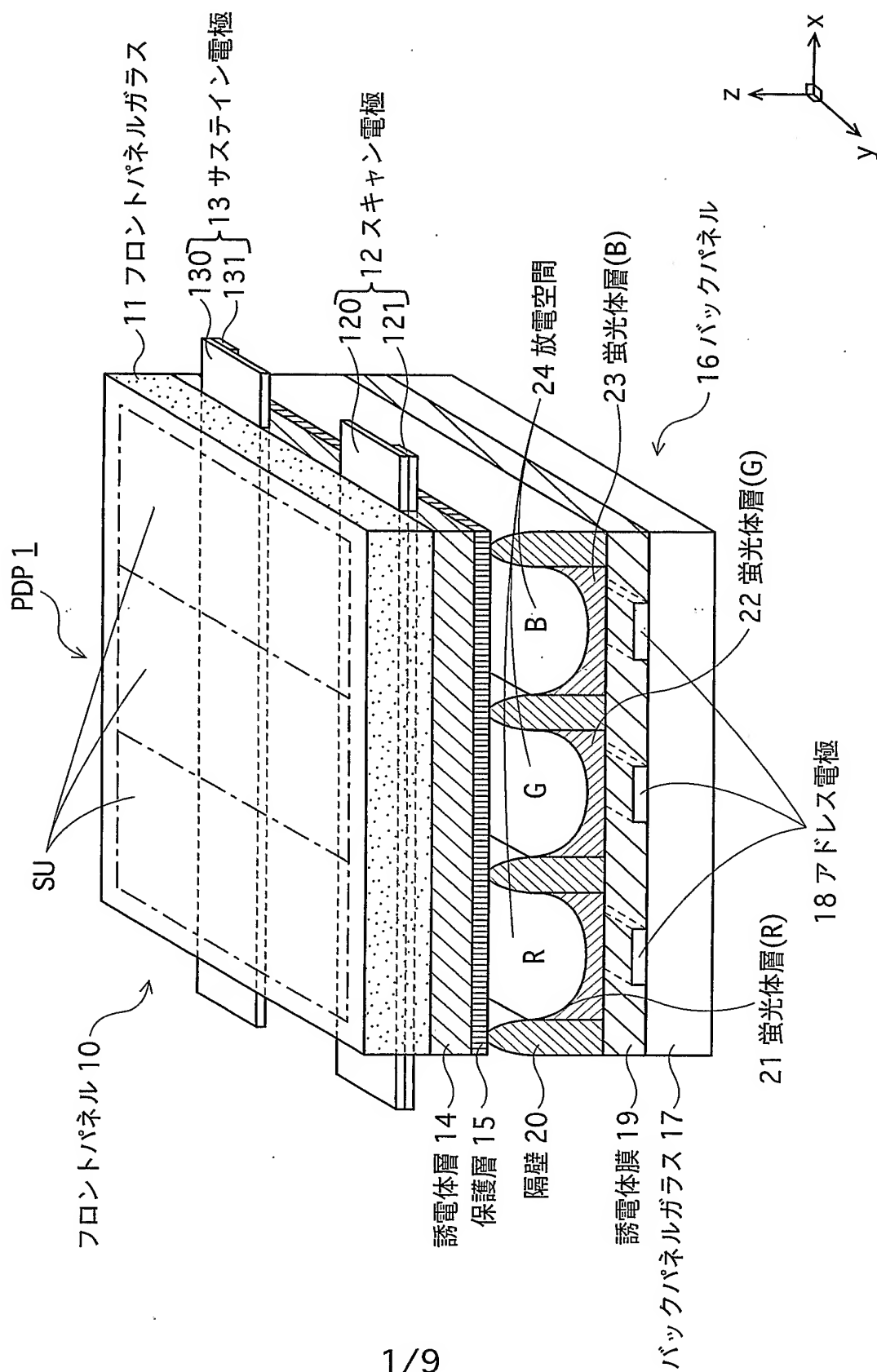


図2

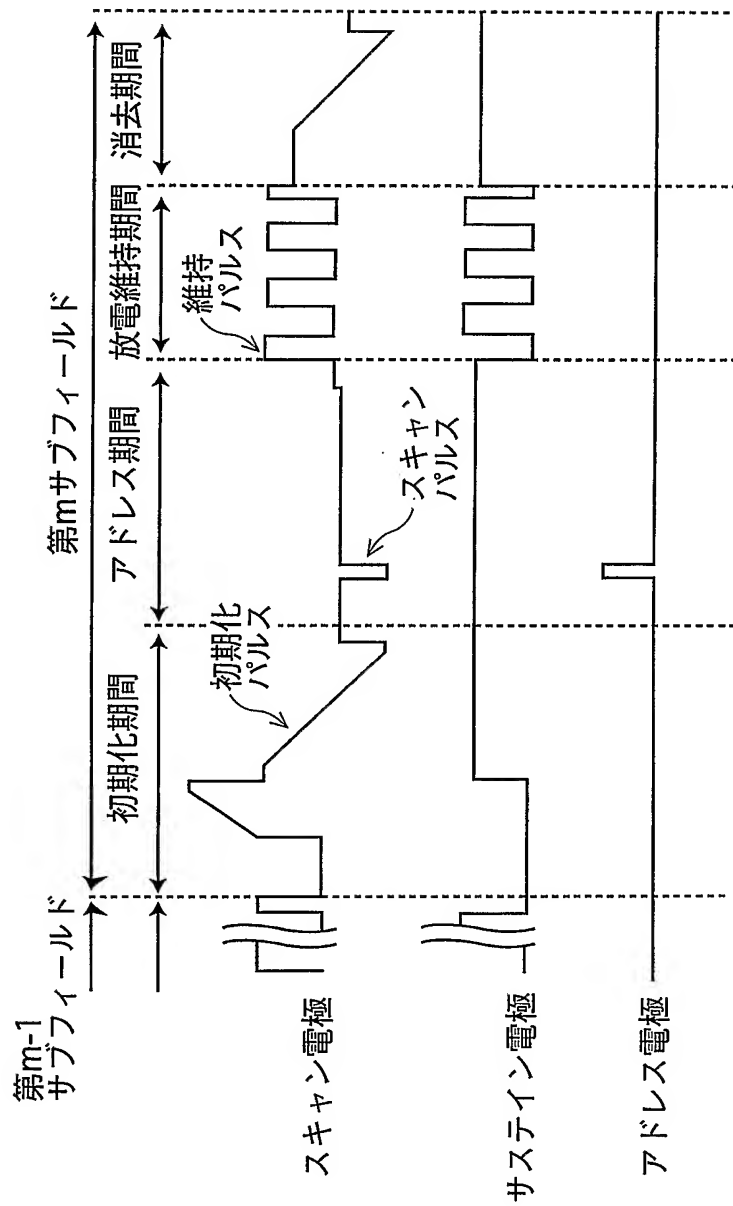


図3

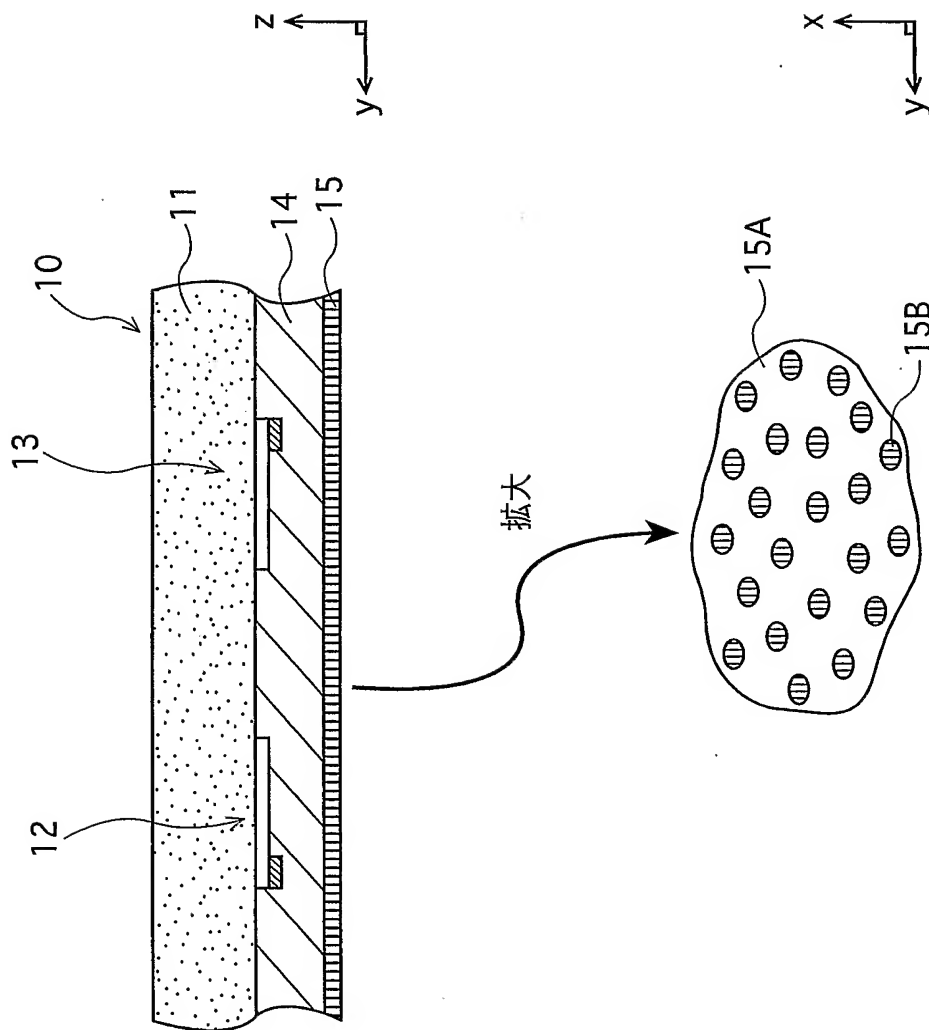


図4

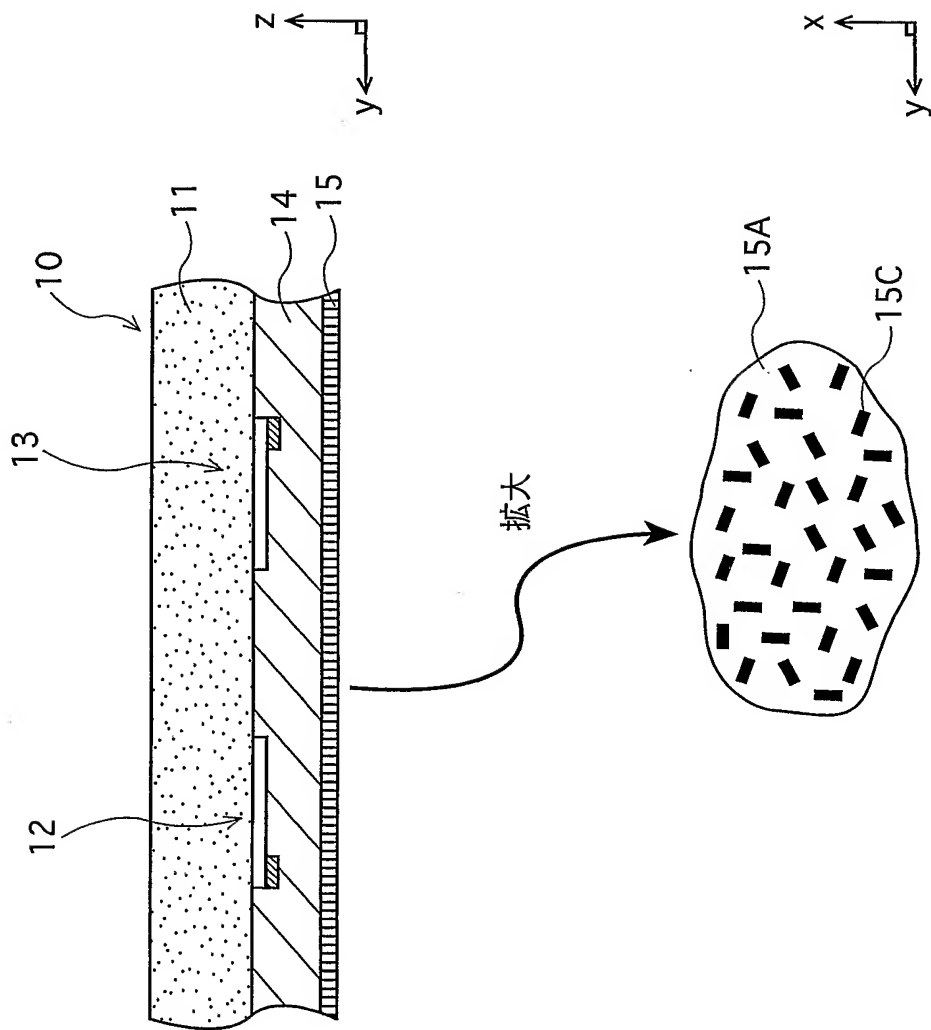


図5

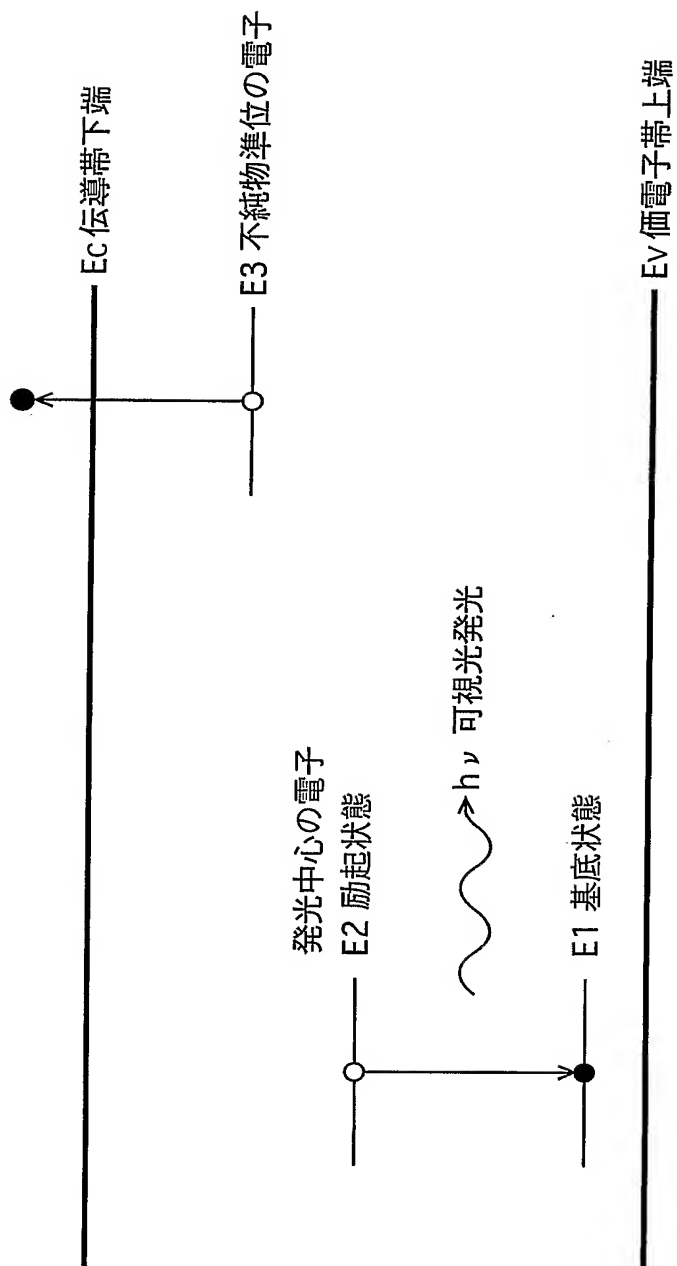


図6

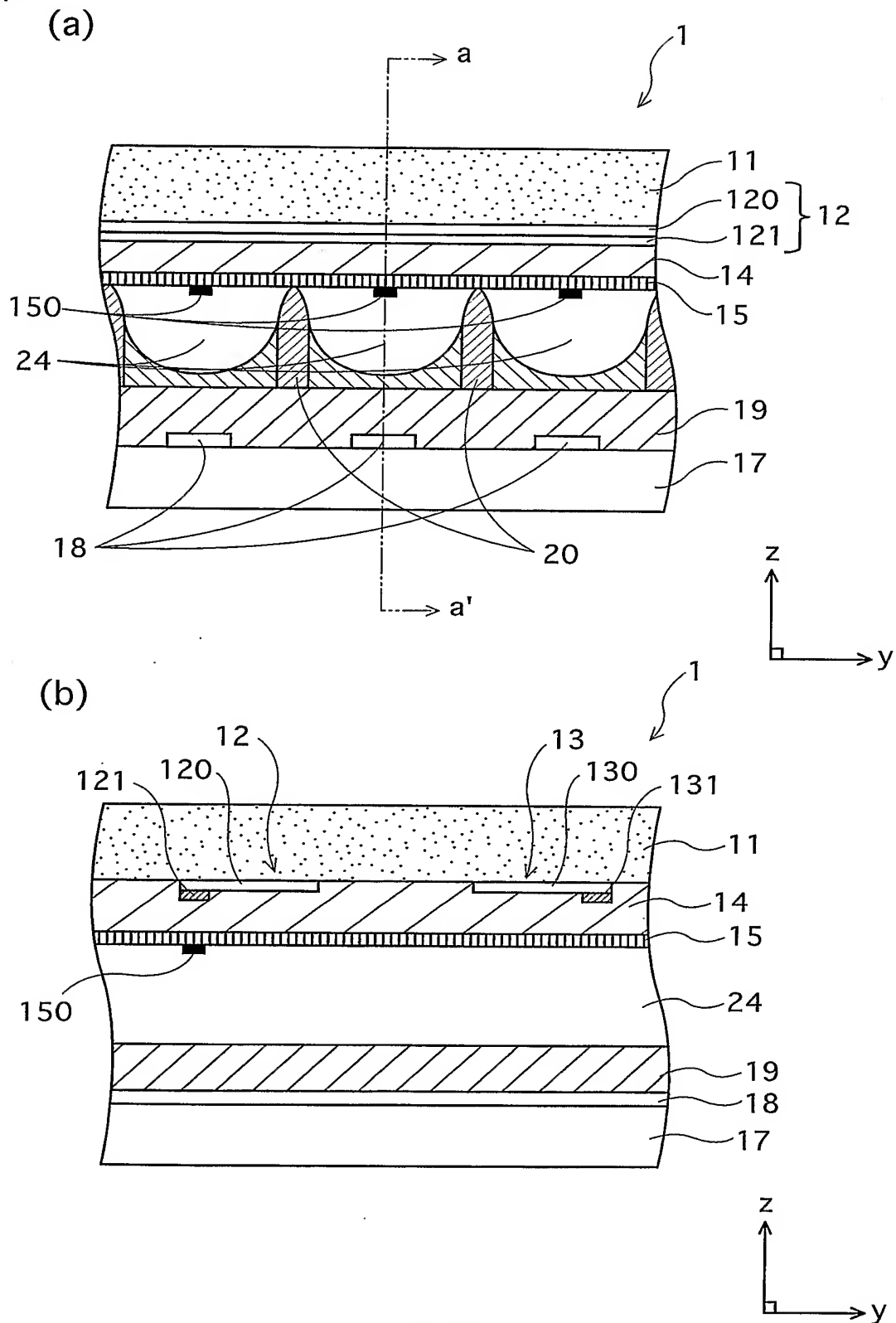


図7

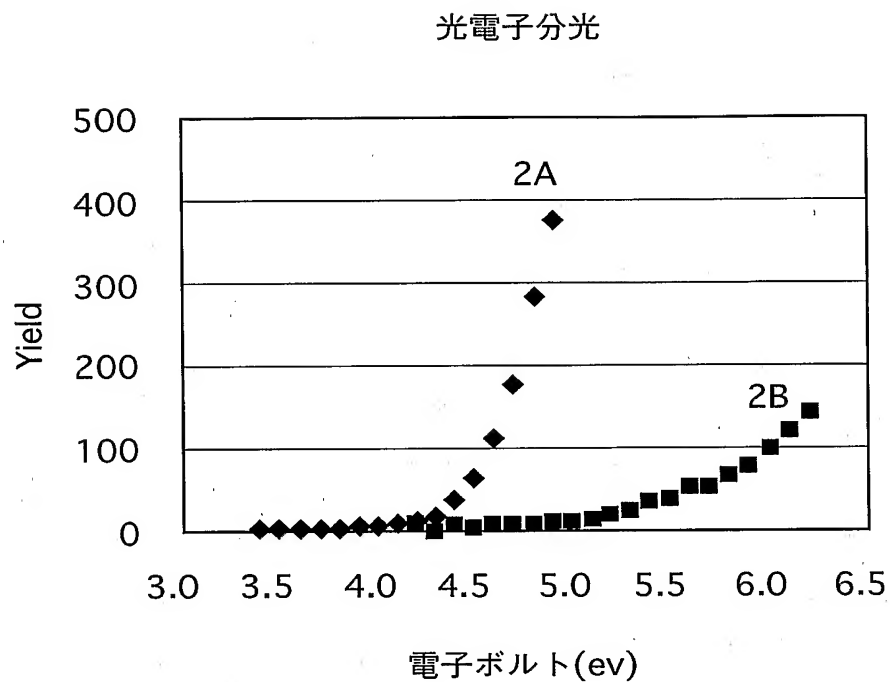


図8

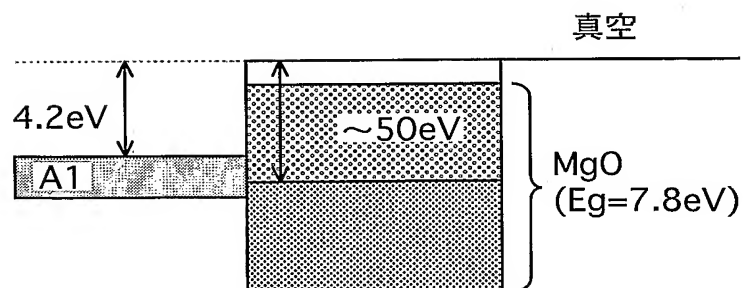


図9

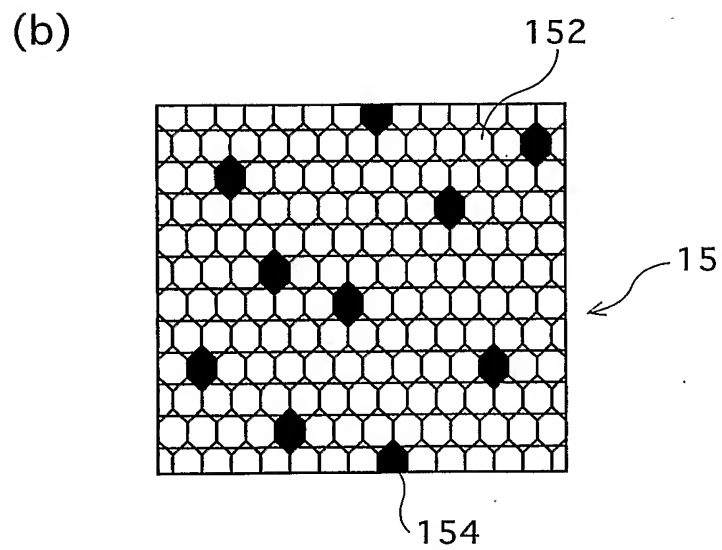
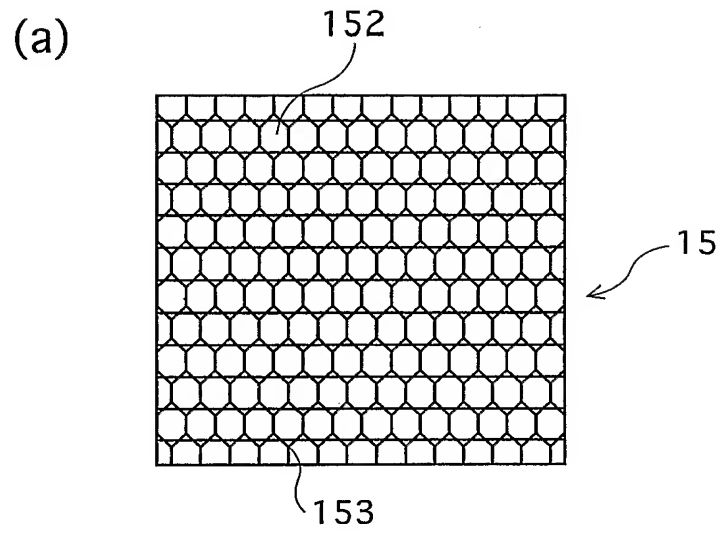
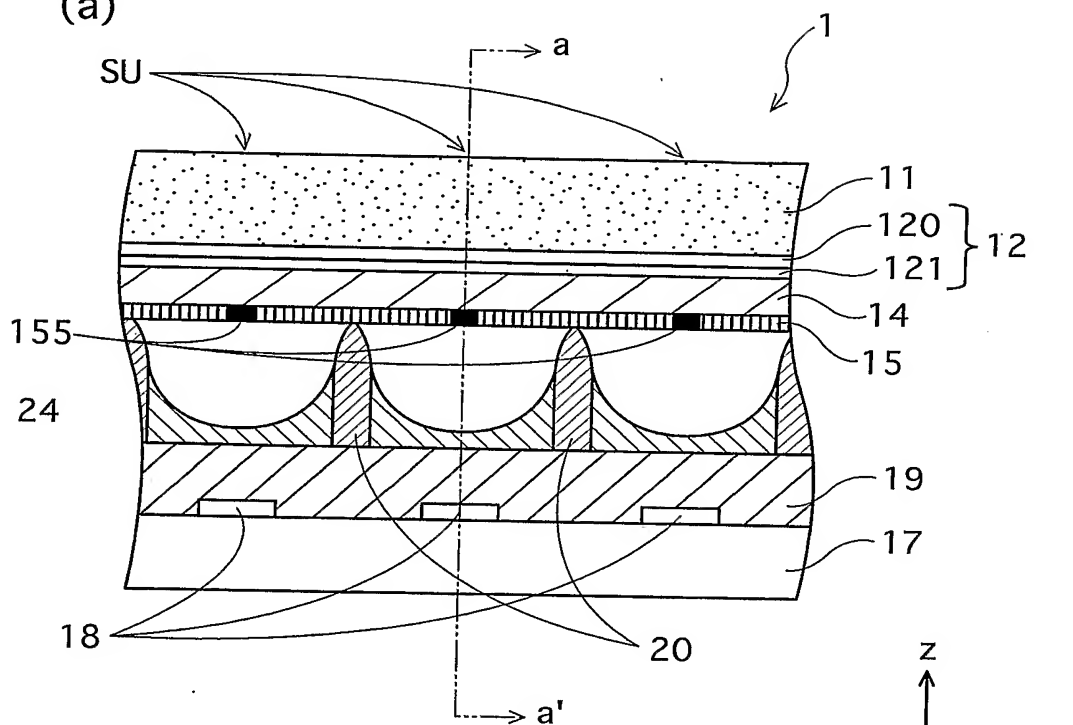
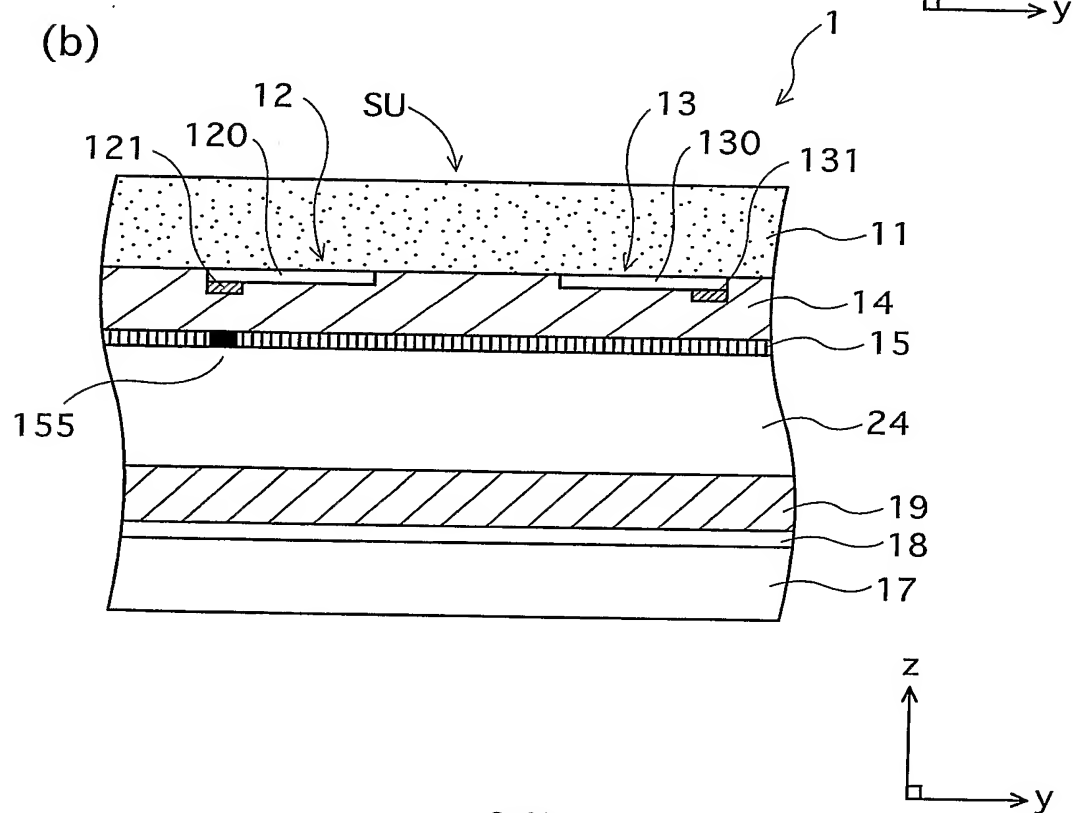


図10

(a)



(b)



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP03/14349

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
Int.Cl.⁷ H01J11/02, 9/02

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
Int.Cl.⁷ H01J11/00-17/64

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2004
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2004	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2004

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP 9-208851 A (Shinto Paint Co., Ltd.), 12 August, 1997 (12.08.97), Full text; all drawings (Family: none)	1-5, 19, 21, 23, 24 6, 7, 25-27
Y		
X	JP 2000-129161 A (Mitsubishi Materials Corp.), 09 May, 2000 (09.05.00), Full text; all drawings (Family: none)	1-5, 19, 21, 23, 24
Y	JP 2000-76989 A (Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.), 14 March, 2000 (14.03.00), Par. Nos. [0023] to [0030] (Family: none)	6

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☐ See patent family annex.

<p>* Special categories of cited documents:</p> <p>"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance</p> <p>"E" earlier document but published on or after the international filing date</p> <p>"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)</p> <p>"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means</p> <p>"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed</p>	<p>"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention</p> <p>"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone</p> <p>"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art</p> <p>"&" document member of the same patent family</p>
--	---

Date of the actual completion of the international search
05 February, 2004 (05.02.04)

Date of mailing of the international search report
17 February, 2004 (17.02.04)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/14349

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 57-182942 A (International Business Machines Corp.), 11 November, 1982 (11.11.82), Page 2, lower right column, line 12 to page 3, upper left column, line 9 & EP 64149 A & US 4475060 A	7,25-27
Y	JP 11-86738 A (Fujitsu Ltd.), 30 March, 1999 (30.03.99), Full text; all drawings (Family: none)	8,20,22,28
Y	JP 2002-124180 A (Canon Inc.), 26 April, 2002 (26.04.02), Par. No. [0071] (Family: none)	8,20,22,28
P,X	JP 2003-272530 A (Toray Industries, Inc.), 26 September, 2003 (26.09.03), Full text; all drawings, particularly, Par. No. [0036] (Family: none)	8,20,22,28
X	JP 11-238462 A (Fujitsu Ltd.), 31 August, 1999 (31.08.99), Full text; all drawings, particularly, Par. Nos. [0021] to [0023] (Family: none)	9-13,15,16, 18
A	JP 2002-117771 A (Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.), 19 April, 2002 (19.04.02), Full text; all drawings (Family: none)	8,20,22,28
A	JP 2001-222944 A (Samsung SDI Kabushiki Kaisha), 17 August, 2001 (17.08.01), Full text; all drawings & EP 1122759 A & KR 2001/77686 A & US 6346775 B1	8,20,22,28
A	JP 2001-176400 A (Pioneer Electronic Corp.), 29 June, 2001 (29.06.01), Full text; all drawings (Family: none)	12,18
A	JP 9-12976 A (Oki Electric Industry Co., Ltd.), 14 January, 1997 (14.01.97), Full text; all drawings (Family: none)	1-7,19,21, 23-27

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ H01J11/02, 9/02

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ H01J11/00-17/64

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2004年
日本国登録実用新案公報	1994-2004年
日本国実用新案登録公報	1996-2004年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	J P 9-208851 A (神東塗料株式会社) 1997. 08. 12, 全文, 全図 (ファミリーなし)	1-5, 19, 21, 23, 24
Y		6, 7, 25-27
X	J P 2000-129161 A (三菱マテリアル株式会社) 2000. 05. 09, 全文, 全図 (ファミリーなし)	1-5, 19, 21, 23, 24

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献
「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

05. 02. 2004

国際調査報告の発送日

17. 2. 2004

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/J P)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

堀部 修平

2 G

9 2 1 5

電話番号 03-3581-1101 内線 3225

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	J P 2000-76989 A (松下電器産業株式会社) 2000.03.14, 段落【0023】-【0030】 (ファミリーなし)	6
Y	J P 57-182942 A (インターナショナル・ビジネス・ マシーンズ・コーポレーション) 1982.11.11, 第2頁右下欄12行-第3頁左上欄9行 & EP 64149 A & US 4475060 A	7, 25-27
Y	J P 11-86738 A (富士通株式会社) 1999.03.30, 全文, 全図 (ファミリーなし)	8, 20, 22, 28
Y	J P 2002-124180 A (キヤノン株式会社) 2002.04.26, 段落【0071】 (ファミリーなし)	8, 20, 22, 28
P, X	J P 2003-272530 A (東レ株式会社) 2003.09.26, 全文, 全図, 特に段落【0036】 (ファミリーなし)	8, 20, 22, 28
X	J P 11-238462 A (富士通株式会社) 1999.08.31, 全文, 全図, 特に、段落【0021】- 【0023】 (ファミリーなし)	9-13, 15, 16, 18
A	J P 2002-117771 A (松下電器産業株式会社) 2002.04.19, 全文, 全図 (ファミリーなし)	8, 20, 22, 28
A	J P 2001-222944 A (三星エスディアイ株式会社) 2001.08.17, 全文, 全図 & EP 1122759 A & KR 2001/77686 A & US 6346775 B1	8, 20, 22, 28
A	J P 2001-176400 A (パイオニア株式会社) 2001.06.29, 全文, 全図 (ファミリーなし)	12, 18
A	J P 9-12976 A (沖電気工業株式会社) 1997.01.14, 全文, 全図 (ファミリーなし)	1-7, 19, 21, 23-27